

1 特殊构型, 唯一性定理, 电像法与 Green 定理等

1.1 本构关系

对均匀带电球面:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}.$$

对均匀带电球:

$$Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \iff \rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}.$$

1.2 特殊构型

几何	源电荷	场
均匀带电导线	λ	$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{\mathbf{r}}$
均匀带电平面	σ	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
均匀带电球壳	Q	球外: $\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$
均匀带电圆盘	σ	中轴线: $V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - z)$
均匀带电圆环	Q	中轴线: $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}}$
均匀带电球	Q	球内: $\mathbf{E} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{\mathbf{r}}, U = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R} - \frac{Qr^2}{8\pi\epsilon_0 R^3}$ 球外: $\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$
偶极子	\mathbf{p}	$\mathbf{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{z} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{z}]$ $U = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
球壳	$\sigma =$ $\sigma_0 \cos \theta$	球内: $\mathbf{E} = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \hat{\mathbf{z}}$ 球外: $\mathbf{E} = \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^3} [3(\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{z}}]$

构型	能量
----	----

均匀带电球	$W = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$
均匀带电球面	$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

原构型	源电荷	等效构型	等效电荷	有效区域
有限导线	λ	切圆投影	λ	单点
带电球壳	$\sigma = \sigma_0 \cos \theta$	均匀极化球	$\mathbf{P} = \sigma \hat{\mathbf{z}}$	球外

构型	电容
平行板电容器	$C = \frac{\epsilon S}{b-a}$
圆柱电容器	$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\log(b/a)}$
球形电容器	$C = \frac{4\pi\epsilon}{1/a - 1/b}$

场	常用边界条件	适用条件	退化情形
\mathbf{E}	$E_{2n} - E_{1n} = \sigma/\epsilon_0$ $\mathbf{E}_2^{\parallel} = \mathbf{E}_1^{\parallel}$	真空 无条件	无面电荷: $E_{2n} = E_{1n}$
\mathbf{D}	$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$	介质边界	无自由面电荷: $D_{2n} = D_{1n}$
V	$\epsilon_1 \frac{\partial V}{\partial n} - \epsilon_2 \frac{\partial V}{\partial n} = \sigma_f$	介质边界	无自由面电荷: $\epsilon_1 \frac{\partial V}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial V}{\partial n}$
\mathbf{J}	$J = \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2$	稳恒电流	
n 皆表示从 1 指向 2.			

注意

$D//$ 在边界处不连续.

1.3 唯一性定理

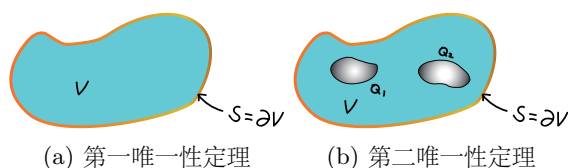


图 1

定理 1.1 (第一唯一性定理). 如图 1a, 若

1. $S = \partial V$ 上的电势 $\varphi|_S$ 给定;
2. V 内部的电荷分布 ρ 已知;

则 φ 在 V 内唯一确定.

定理 1.2 (第二唯一性定理). 如图 1b, 若

1. $S = \partial V$ 上的电势 $\varphi|_S$ 给定;
2. 诸导体上电荷量 Q_i 给定;
3. V 内部的电荷分布 ρ 已知;

则 φ 在 V 内唯一确定.

推论 1.1 (导体静电场叠加原理). 设空间中有固定导体,

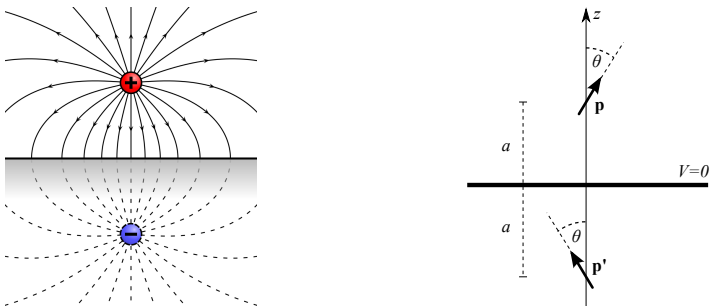
1. 当诸导体电势为 φ_i , 相应带电量为 Q_i , 空间电势为 φ ;
2. 当诸导体电势为 φ'_i , 相应带电量为 Q'_i , 空间电势为 φ' ;

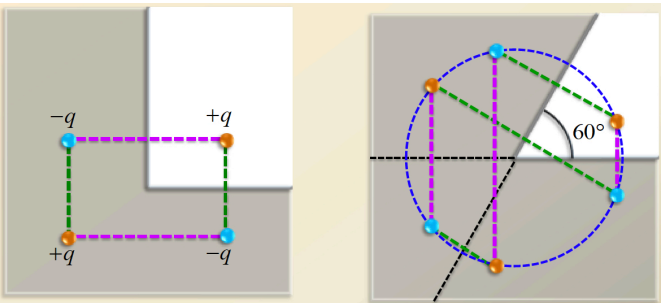
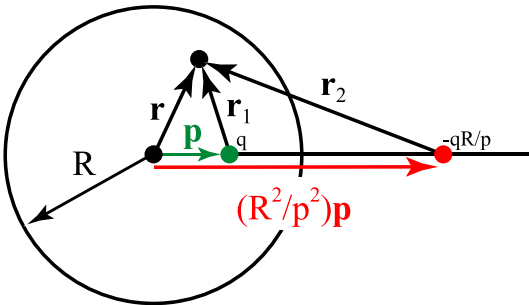
则诸导体电势为 $\varphi_i + \varphi'_i$ 时, 相应带电量为 $Q_i + Q'_i$, 空间电势为 $\varphi + \varphi'$.

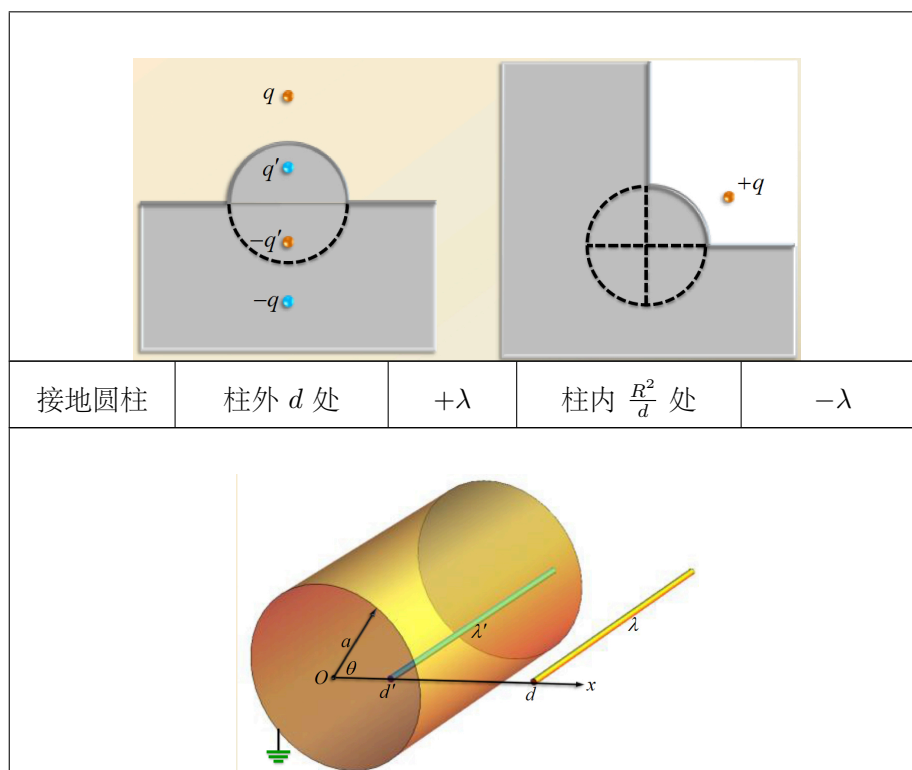
1.4 电像法

定理 1.3 (电像法的原则).

1. 源电荷位置即解的有效位置;
2. 像电荷之和恰好等于该区域内电荷之和.

导体	源位置	源电荷	像位置	像电荷
接地平面	上方 $+d$	$+q$	下方 $-d$	$-q$
接地平面	上方 $+d$	\mathbf{p}	下方 $-d$	\mathbf{p} 沿 z 反射
电介质			上方 $+d$	$\frac{\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\epsilon_2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}q$
下方 ϵ_2	下方 $-d$	$+q$	下方 $-d$	$q \mapsto \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2}q$
上方 ϵ_1			下方 $-d$	$\frac{\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\epsilon_2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}q$
				
接地垂直	导体板间	$+q$	连续 2 次反射	$\pm q$
接地 60°	导体板间	$+q$	连续 3 次反射	$\pm q$

				
接地球壳	球外 d 处	$+q$	球内 $\frac{R^2}{d}$ 处	$-\frac{R}{d}q$
带电球壳	球外 d 处	$+q$	球内 $\frac{R^2}{d}$ 处	$q' = -\frac{R}{d}q$
	球壳	Q	球内 O 处	$Q - q'$
接地球壳	球内 d 处	$+q$	球外 $\frac{R^2}{d}$ 处	$-\frac{R}{d}q$
恒 φ_0 球壳	球内 d 处	$+q$	球外 $\frac{R^2}{d}$ 处	$-\frac{R}{d}q$
	球壳表面	电势 φ_0	球壳表面	$\sigma' = \epsilon_0 \varphi_0 / R$
				
接地球壳	轴上方 $+d$	$+q$	轴上方 $\frac{R^2}{d}$ 处	$q' = -\frac{R}{d}q$
组合平面			沿平面反射	$\pm q, \pm q'$
接地球壳	板间球外 R 处	$+q$	板间球内 $\frac{R^2}{d}$ 处	$q' = -\frac{R}{d}q$
组合垂直			连续 2 次反射	$\pm q, \pm q'$



注意

球壳的 $q' \neq -q$, 但圆柱的 $\lambda' = -\lambda$. 且二者的半径位置相同.

1.4.1 对称性论证

对于具有旋转对称性的构型, 通过对线圈的 U 积分求出轴线上的 U 和 \mathbf{E} .

1.5 积分及其他数学

常用积分:

$$\int \sqrt{x^2 + z^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 + z^2} + \frac{1}{2} z^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + z^2} \right).$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 + z^2} \right). \\
\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx &= \sqrt{x^2 + z^2}. \\
\int \frac{1}{(x^2 + z^2)^{3/2}} dx &= \frac{x}{z^2 \sqrt{x^2 + z^2}}. \\
\int \frac{x}{(x^2 + z^2)^{3/2}} dx &= -\frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}}. \\
\int \frac{x^2}{(x^2 + z^2)^{3/2}} dx &= -\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} + \ln \left| x + \sqrt{x^2 + z^2} \right|. \\
\int \frac{1}{\sqrt{r^2 + z^2 - 2rzu}} du &= \frac{1}{rz} \sqrt{r^2 + z^2 - 2rzu}. \\
\int \frac{1}{1+t} \frac{1}{\sqrt{1+(r^2+1)t}} dx &= \frac{2}{r} \arctan \frac{\sqrt{1+(r^2+1)x}}{r}. \\
\int \frac{1+r}{r^2} e^{-r} dr &= -\frac{e^{-r}}{r}. \\
\int r e^{-r} dr &= e^{-r} (-1-r). \\
\int r^2 e^{-r} dr &= e^{-r} (-2-2r-r^2). \\
\int r^n e^{-r} dr &= e^{-r} \left(-n! - \frac{n!}{1!}r - \frac{n!}{2!}r^2 - \dots - \frac{n!}{n!}r^n \right).
\end{aligned}$$

参考 HG.p.222.6.(1).,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ even}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ odd}. \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos x} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

注意

对于 $y'' = \lambda y^n$ 型的方程, 不能通过设 $y = (ax + b)^\mu$ 求解, 必须分离变量.

Legendre 多项式展开:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2x \cos \theta + x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) x^n.$$

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x^2).$$

曲线坐标系下的散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} (s F_s) + \frac{1}{s} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

1.6 结论**1.6.1 一般静电学**

cf.G.2.43., 计算电荷分布之一部受令一部施加的力时, 可直接对 $\rho \mathbf{E}$ 积分, 盖任何分布皆不对自身有静电力.

cf.G.2.33., 将小量 dq 沿等势面涂抹, 做功为零.

注意

cf.M.3.14., 计算电荷分布能量时, 若为外场导致能量则无需 $\frac{1}{2}$ 因子, 反之自能需要 $\frac{1}{2}$ 因子.

电荷分布能量为

$$W = \sum_i W_{i \text{ self}} + \sum_{i \neq j} W_{ij \text{ inter}}.$$

1.6.2 电介质中的静电学

参考 HG.2.21., 电介质中叠加原理亦适用, 适用电像法时可以先引入一个源电荷, 再引入第二个源电荷.

1. 电介质填充介面为等势面时, \mathbf{D} 前后不变, 即 $\mathbf{E} \mapsto \mathbf{E}/\epsilon_r$.
2. 电介质填充介面沿电场线时, 可假设 $\mathbf{E} \mapsto \alpha \mathbf{E}$ 处处一致成立, 通过适当边界条件确定 α . 参考 M.2.3.31.

介质自动将任何自由电荷约化为 $q \mapsto q/\epsilon_r$ (例如介质内嵌电荷), $\sigma \mapsto \sigma/\epsilon_r$ (例如电容边界处).

1.6.3 电容器相关

电容器几何量

$$U = \frac{Q}{C}, \quad Q = CU, \quad C = \frac{Q}{U}.$$

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU.$$

电容器串联时, 能量 $W_1 \propto C_2$, $W_2 \propto C_1$, 并联时 $W_1 \propto C_1$, $W_2 \propto C_2$, 注意与电阻的情形区分.

参考 M.3.34., 3.35., 3.47, 带电电容器的串接: 电容直接视为并联, 电量直接中和. 电容器内不完全插入电介质, 分解为电容器的串/并联.

参考 M.2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.25., 存在共用极板/覆叠极板时, 考虑将极板拆分为电容并联.

参考 M.3.38., 3.39., 电容器极板受力

$$F = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S.$$

区别于真空下的受力 (cf.G.2.37.)

$$F = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 S.$$

参考 M.3.40., 电容器对导体的力矩为

$$M = \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)_U = - \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)_Q.$$

M 为正时力矩使 θ 有增大趋势.

通过对 F 积分计算电容吸入电介质做功时, 自电介质达边界处始积分.

1.6.4 电流

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

两个理想导体在无限均匀电介质中成立

$$RC = \rho\epsilon.$$

体电流发热功率

$$P = \iint \sigma E^2 dV.$$

注意

$$R = \int_a^b \frac{dr}{\sigma \cdot S}.$$

特别地, 对于球壳,

$$R = \int_a^b \frac{dr}{\sigma \cdot 4\pi r^2}.$$

尤其注意分子分母的位置.